

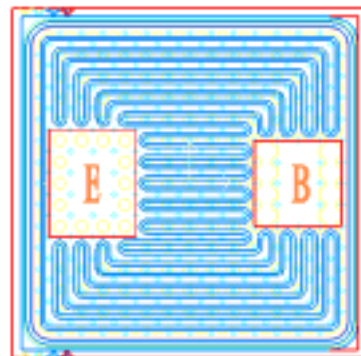


B834 晶体管芯片说明书

■ 芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
芯片代码：A126AG-01
芯片厚度：240±20μm
管芯尺寸：1260×1260μm²
焊位尺寸：B 极 308×308μm²；E 极 308×385μm²
电极金属：铝
背面金属：银
典型封装：2SB834，HB834

■ 管芯示意图

■ 极限值（T_a=25℃）（封装形式：TO-220）

T_{stg}——贮存温度…………… -55~150℃
T_j——结温……………150℃
P_C——集电极耗散功率……………30W
V_{CBO}——集电极—基极电压…………… -60V
V_{CEO}——集电极—发射极电压…………… -60V
V_{EBO}——发射极—基极电压……………-7V
I_C——集电极电流…………… -3A
I_B——基极电流…………… -0.3A

■ 电参数（T_a=25℃）（封装形式：TO-220）

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			-100	μA	V _{CB} =-60V, I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			-100	μA	V _{EB} =-7V, I _C =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-60				I _C =-50mA, I _B =0
h _{FE}	直流电流增益	60		300		V _{CE} =-5V, I _C =-0.5A
	直流电流增益	20				V _{CE} =-5V, I _C =-3A
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压		-0.5	-1	V	I _C =-3A, I _B =-0.3A
V _{BE(on)}	基极—发射极导通电压		-0.7	-1	V	V _{CE} =-5V, I _C =-0.5A
f _T	特征频率		-9		MHz	V _{CE} =-5V, I _C =-0.5A
C _{ob}	共基极输出电容		-150		pF	V _{CB} =-10V, I _E =0, f=1.0 MHz
t _{ON}	导通时间		0.4		μs	V _{CE} =-30V, I _C =-2A -I _{B1} =I _{B2} =0.2A
t _{STG}	载流子贮存时间		1.7		μs	
t _F	下降时间		0.5		μs	